

InGaAs фотодиод 1740 нм, 1000 мкм, с однокаскадным ТЕС, ТО-корпус — техническое описание

P/N: WET3-1000B

ОСОБЕННОСТИ:

Высокая чувствительность; низкий темновой ток; спектральная чувствительность 900–1740 нм

ПРИМЕНЕНИЕ:

Детектирование в ближнем ИК-диапазоне

Мониторинг

Измерительные приборы

Электрооптические характеристики (T=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Чувствительность	R	$\lambda=1654\text{nm}, -5\text{V}$	0.9	1		А/Вт
Темновой ток	Id	VR=-5V			5.0	нА
Емкость	C	VR=-5V, f=1MHZ		55	65	пФ
Активная область	φ	-	995	1000	1005	мкм
Рабочий диапазон длин волн	λ	-	900	1650	1740	нм

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Обозначение	Мин.	Макс.	Ед. изм.
Рабочая температура	Top	-40	85	°C
Температура хранения	Tstg	-40	125	°C
Прямой ток	IF	-	10	мА
Обратное напряжение	VR	0	20	В

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Сопротивление термистора	Rt	T=25 °C	-	10	-	кОм
В-константа термистора	B	T=25 °C	-	3950	-	K
Ток ТЕС	Ic	-40~120 °C	-	-	2	A
Напряжение ТЕС	Vc	-40~120 °C	-	-	2.5	B

Назначение выводов и габаритный чертёж

